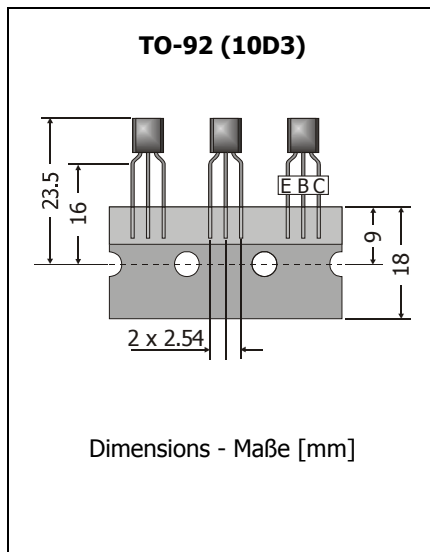


MPSA92
High Voltage PNP Transistors
Hochspannungs-PNP-Transistoren

$I_C = - 500 \text{ mA}$
 $h_{FE} = 25$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = - 300 \text{ V}$
 $P_{tot} = 625 \text{ mW}$

Version 2016-01-04

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

High blocking voltage
 High collector current
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped in ammo pack 4000
 Weight approx. 0.18 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Sperrspannung
 Hoher Kollektorstrom
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet im Ammo-Pack
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings (T_A = 25°C)**Grenzwerte (T_A = 25°C)**

			MPSA92
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	300 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	300 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EB0}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ²⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I _C	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

			Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
I _E = 0, - V _{CB} = 200 V	MPSA92	- I _{CBO}	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
I _B = 0, - V _{EB} = 3 V		- I _{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ³⁾					
- I _C = 20 mA, - I _B = 2 mA	MPSA92	- V _{CEsat}	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ³⁾					
- I _C = 20 mA, - I _B = 2 mA		- V _{BEsat}	–	–	0.9 V

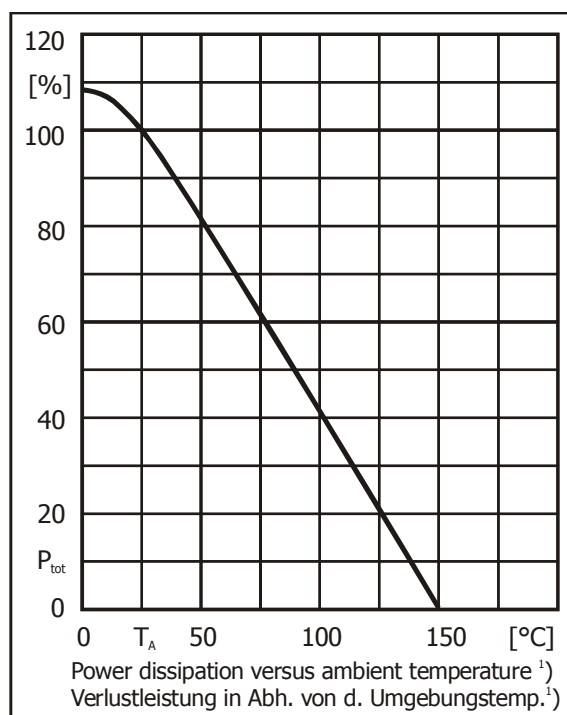
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

3 Tested with pulses tp = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen tp = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 10\text{ V}$, - $I_C = 1\text{ mA}$	h_{FE}		25		
- $V_{CE} = 10\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$	h_{FE}		40		
- $V_{CE} = 10\text{ V}$, - $I_C = 30\text{ mA}$	h_{FE}		25	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 20\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T		–	70 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
- $V_{CB} = 20\text{ V}$, - $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$	MPSA92	C_{CB0}	–	–	7 pF
Thermal resistance junction – ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren			MPSA42, MPSA44		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden